

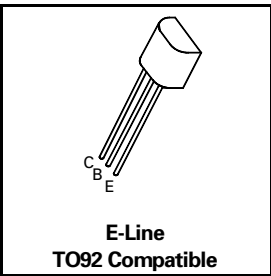
# PNP SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTORS

**ZTX752  
ZTX753**

ISSUE 2 – JULY 94

## FEATURES

- \* 100 Volt  $V_{CE0}$
- \* 2 Amp continuous current
- \* Low saturation voltage
- \*  $P_{tot}=1$  Watt



## ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	ZTX752	ZTX753	UNIT
Collector-Base Voltage	$V_{CBO}$	-100	-120	V
Collector-Emitter Voltage	$V_{CEO}$	-80	-100	V
Emitter-Base Voltage	$V_{EBO}$	-5		V
Peak Pulse Current	$I_{CM}$	-6		A
Continuous Collector Current	$I_C$	-2		A
Power Dissipation at $T_{amb}=25^\circ\text{C}$ derate above $25^\circ\text{C}$	$P_{tot}$	1 5.7		W mW/ $^\circ\text{C}$
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +200		$^\circ\text{C}$

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	ZTX752			ZTX753			UNIT	CONDITIONS.
		MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.		
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	-100			-120			V	$I_C=-100\mu\text{A}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	-80			-100			V	$I_C=-10\text{mA}^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	-5			-5			V	$I_E=-100\mu\text{A}$
Collector Cut-Off Current	$I_{CBO}$			-0.1 -10			-0.1 -10	$\mu\text{A}$ $\mu\text{A}$ $\mu\text{A}$ $\mu\text{A}$	$V_{CB}=-80\text{V}$ $V_{CB}=-100\text{V}$ $V_{CB}=-80\text{V}, T_{amb}=100^\circ\text{C}$ $V_{CB}=-100\text{V}, T_{amb}=100^\circ\text{C}$
Emitter Cut-Off Current	$I_{EBO}$			-0.1			-0.1	$\mu\text{A}$	$V_{EB}=-4\text{V}$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		-0.17 -0.30	-0.3 -0.5		-0.17 -0.30	-0.3 -0.5	V V	$I_C=-1\text{A}, I_B=-100\text{mA}^*$ $I_C=-2\text{A}, I_B=-200\text{mA}^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		-0.9	-1.25		-0.9	-1.25	V	$I_C=-1\text{A}, I_B=-100\text{mA}^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		-0.8	-1		-0.8	-1	V	$I_C=-1\text{A}, V_{CE}=-2\text{V}^*$

# ZTX752 ZTX753

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ ).

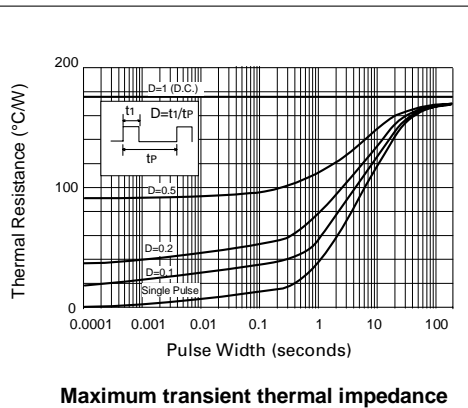
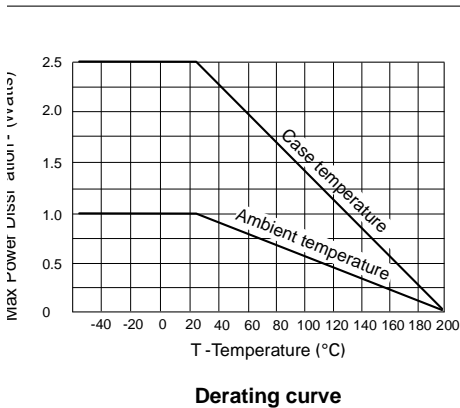
PARAMETER	SYMBOL	ZTX752			ZTX753			UNIT	CONDITIONS.
		MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.		
Transition Frequency	$f_T$	100	140		100	140		MHz	$I_C = -100\text{mA}$ , $V_{CE} = -5\text{V}$ $f = 100\text{MHz}$
Switching Times	$t_{on}$		40			40		ns	$I_C = -500\text{mA}$ , $V_{CC} = -10\text{V}$ $I_{B1} = I_{B2} = -50\text{mA}$
	$t_{off}$		600			600		ns	
Output Capacitance	$C_{obo}$			30			30	pF	$V_{CB} = 10\text{V}$ $f = 1\text{MHz}$

\*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 $\mu\text{s}$ . Duty cycle  $\leq 2\%$

## THERMAL CHARACTERISTICS

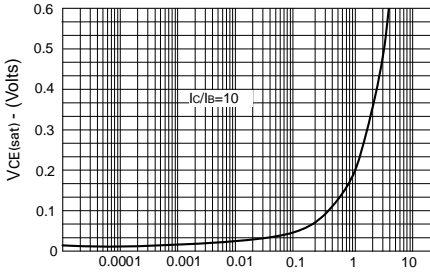
PARAMETER	SYMBOL	MAX.	UNIT
Thermal Resistance: Junction to Ambient <sub>1</sub> Junction to Ambient <sub>2</sub> Junction to Case	$R_{th(j-amb)1}$ $R_{th(j-amb)2} \dagger$ $R_{th(j-case)}$	175 116 70	$^{\circ}\text{C/W}$ $^{\circ}\text{C/W}$ $^{\circ}\text{C/W}$

$\dagger$  Device mounted on P.C.B. with copper equal to 1 sq. Inch minimum.



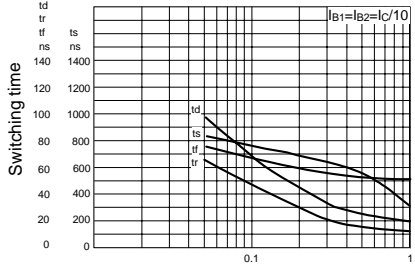
# ZTX752 ZTX753

## TYPICAL CHARACTERISTICS



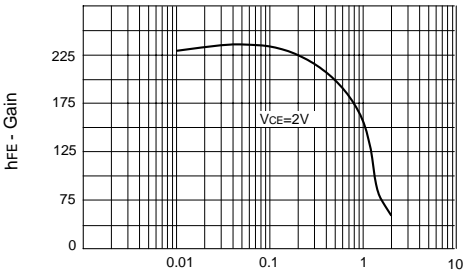
$I_C$  - Collector Current (Amps)

**$V_{CE(sat)}$  v  $I_C$**



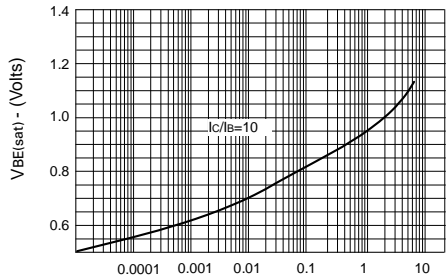
$I_C$  - Collector Current (Amps)

**Switching Speeds**



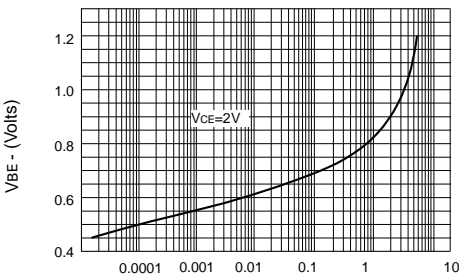
$I_C$  - Collector Current (Amps)

**$h_{FE}$  v  $I_C$**



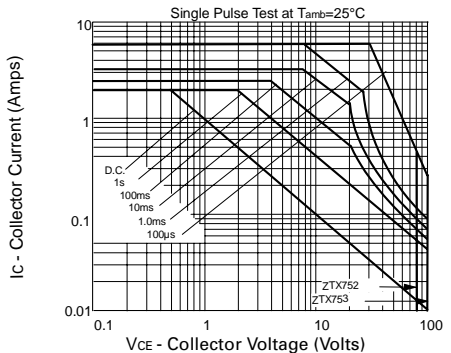
$I_C$  - Collector Current (Amps)

**$V_{BE(sat)}$  v  $I_C$**



$I_C$  - Collector Current (Amps)

**$V_{BE(on)}$  v  $I_C$**



**Safe Operating Area**



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331